

BFG505W; BFG505W/X; BFG505W/XR NPN TRANSISTOR MICROWAVE LOW NOISE AMPLIFIER NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR

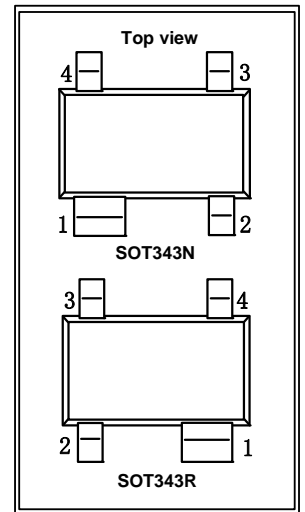
1. 简述:

本芯片采用硅外延工艺制造，具有小信号高增益、宽带、低噪声、低漏电流、小结电容特性，较大的动态范围，理想的电流线性；

主要应用于高频微波、VHF、UHF 和 CATV 高频宽带低噪声初级放大器中，如电视调谐器、卫星电视接收器、模拟数字无绳电话、雷达感应探测器、射频模块和光纤传输中的中继放大器等产品中；

集电极-发射极击穿电压： $BV_{CEO}=15V$ ，最大集电极电流： $I_C=18mA$ ，集电极耗散功率： $P_C=500mW$ ，特征频率： $f_T=9GHz$ ；

采用 4 引脚（宽集电极引脚与双发射极引脚）的 SOT343N 和 SOT343R 表面贴塑封装。



2. 封装形式和引脚定义:

型号(Model)	BFG505W	BFG505W/X	BFG505W/XR
封装形式(Package)	SOT343N	SOT343N	SOT343R
本体激光标示 (Marking)	N0	N1	P0
引脚(Pin)1	collector	collector	collector
引脚(Pin)2	base	emitter	emitter
引脚(Pin)3	emitter	base	base
引脚(Pin)4	emitter	emitter	emitter

3. 极限参数 (Tamb=25℃) :

参数名称	符号	额定值	单位
集电极-基极击穿电压	BV_{CBO}	20	V
集电极-发射极击穿电压	BV_{CEO}	15	V
发射极-基极击穿电压	BV_{EBO}	2.5	V
集电极电流	I_C	18	mA
耗散功率	P_T	500	mW
最高结温	T_J	150	°C
储存温度	T_{stg}	-65 ~ +150	°C

4. 电参数及规格 (Tamb=25℃) :

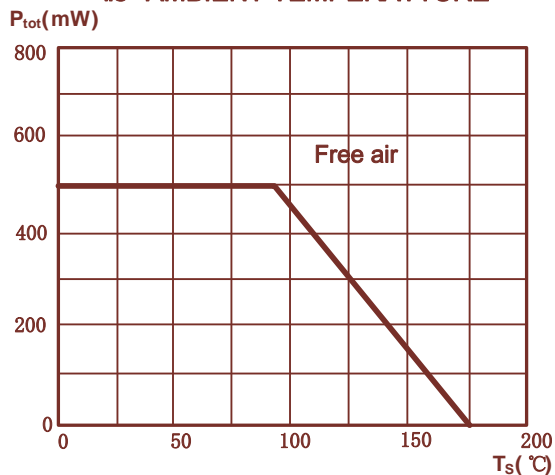
参数名称	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
集电极截止电流	I _{CBO}	V _{CB} =6V, I _E =0	-	-	0.05	μA
直流电流放大系数	h _{FE}	V _{CE} =6V, I _C =5mA	60	120	250	
特征频率	f _T	V _{CE} =6V, I _C =5mA, f=1GHz	-	9	-	GHz
反馈电容	C _{re}	I _C =I _C =0, V _{EB} =6V, f=1MHz	-	0.2	-	pF
集电极电容	C _C	I _E =I _E =0, V _{CB} =6V, f=1MHz	-	0.3	-	pF
发射极电容	C _e	I _C =I _C =0, V _{CB} =0.5V, f=1MHz	-	0.4	-	pF
插入功率增益	$ S_{21} ^2$	I _C =5mA, V _{CE} =6V, f=900MHz	15	16	-	dB
噪声系数	NF	V _{CE} =6V, I _C =1.25mA, f=900MHz	-	1.2	1.7	dB
		V _{CE} =6V, I _C =5mA, f=900MHz	-	1.6	2.1	dB
		V _{CE} =6V, I _C =1.25mA, f=2GHz	-	1.9	-	dB
最大单边功率增益	G _{UM}	I _C =5mA, V _{CE} =6V, f=900MHz	-	19	-	dB
		I _C =5mA, V _{CE} =6V, f=2GHz	-	12	-	dB
输出功率在 1dB 的增益压缩	P _{L1}	I _C =5mA, V _{CE} =6V, R _L =50 Ω, f=900 MHz	-	4	-	dBm

其中: $G_{UM} = 10 \log \frac{|S_{21}|^2}{(1 - |S_{11}|)^2 (1 - |S_{22}|)^2} \text{ dB}$

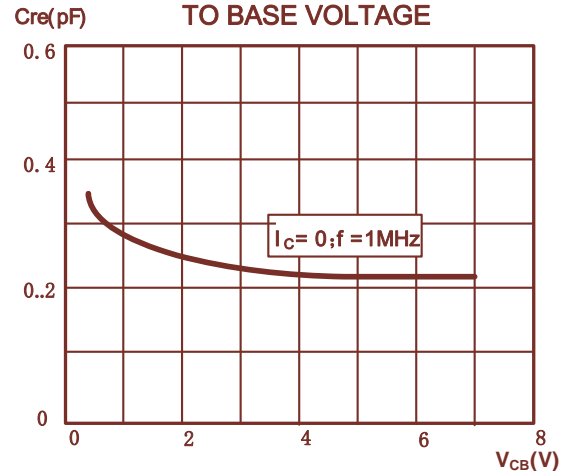
5. 典型特征曲线:

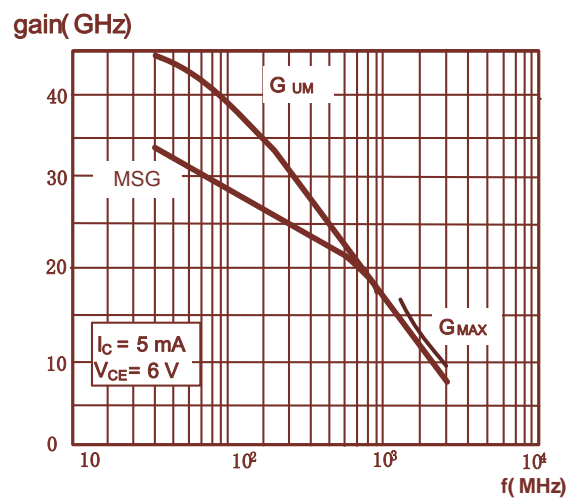
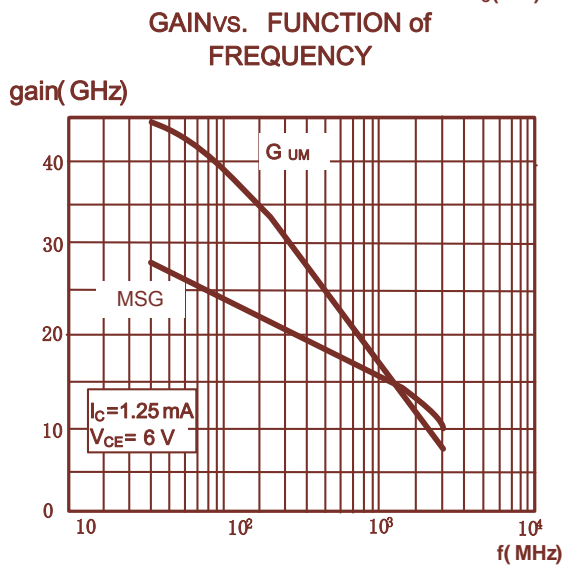
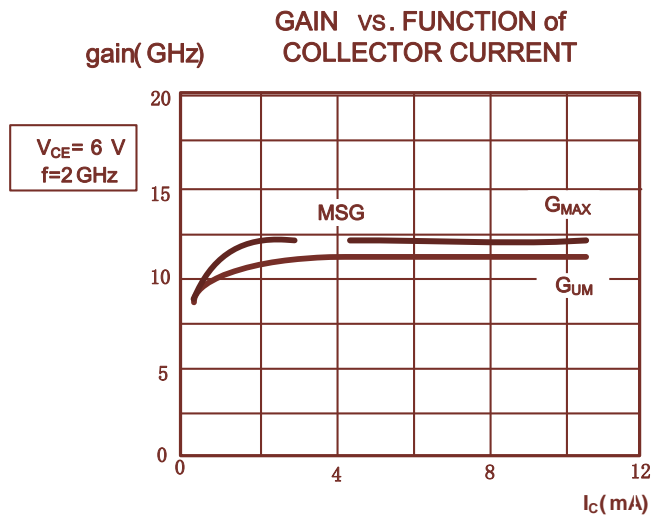
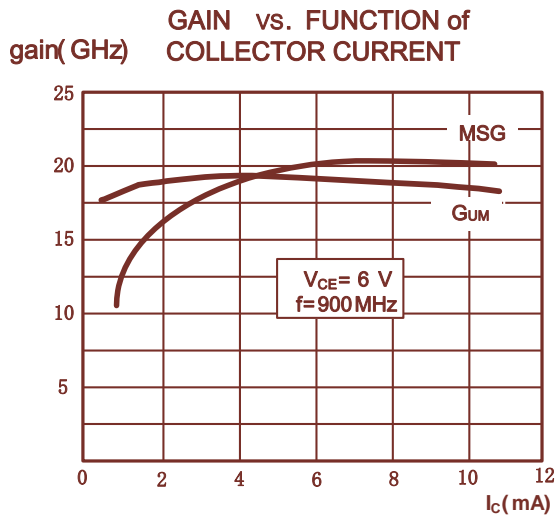
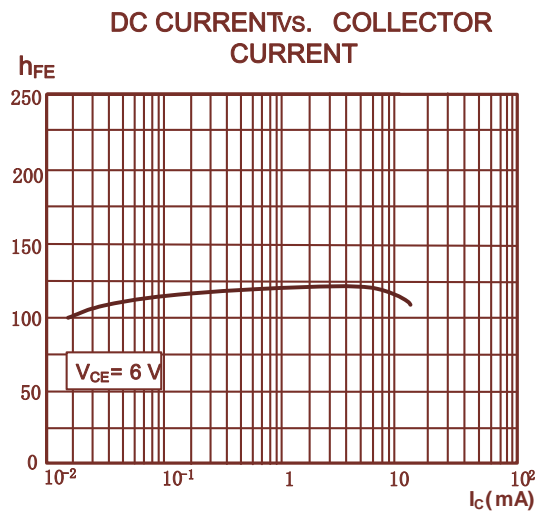
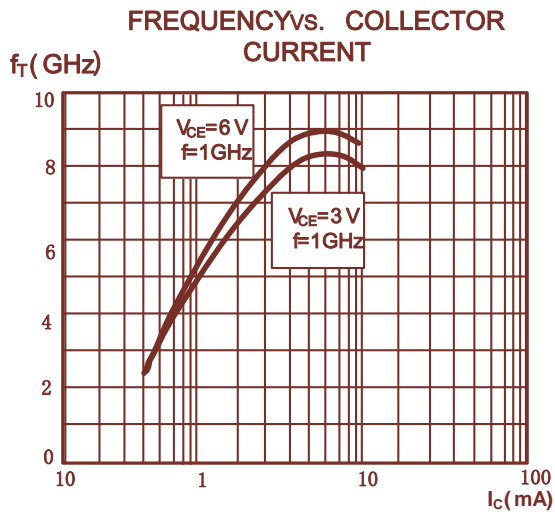
TYPICAL CHARACTERISTICS (T_A=25°C, unless otherwise specified)

TOTAL POWER DISSIPATION
vs AMBIENT TEMPERATURE

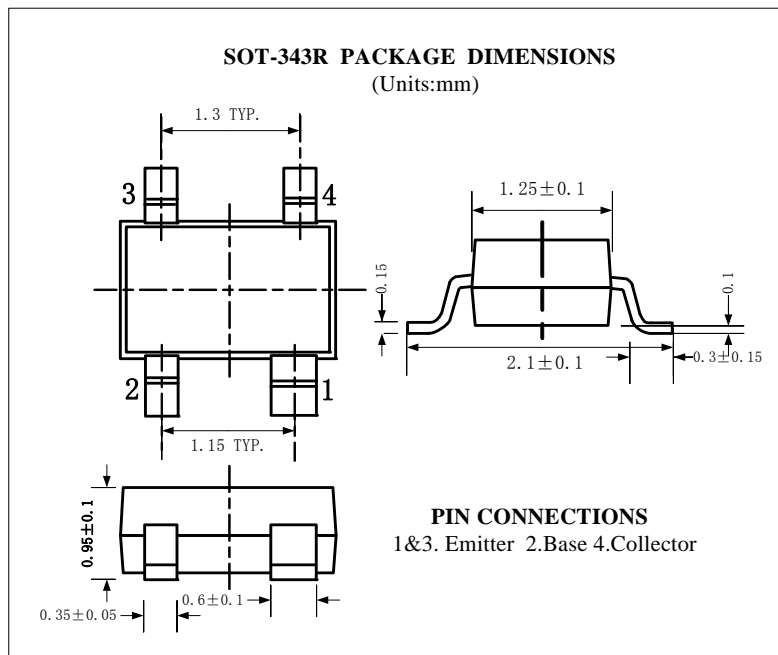
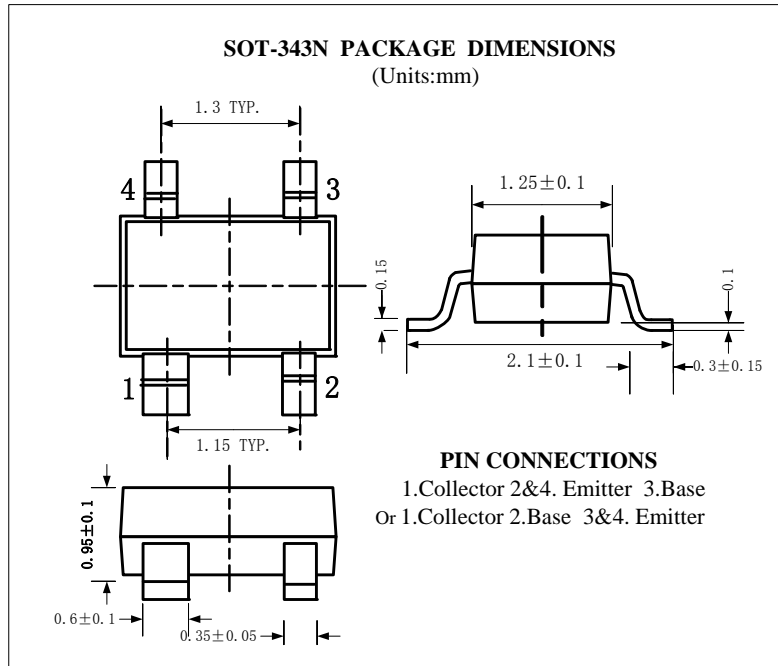


REVERSE TRANSFER
CAPACITANCE'S. COLLECTOR
TO BASE VOLTAGE





5. 封装尺寸示意图:



6. 包装信息:

PACKAGE INFORMATION

封装形式 Package	数量/盘 Shipping	盘/中盒 Inner Box	中盒/箱 Carton
SOT343N	3000pcs/Tape&Reel	15Tape&Reel	4 Inner Box
SOT343R	3000pcs/Tape&Reel	15Tape&Reel	4 Inner Box